# Температурная и частотная зависимости времен спин-решеточной релаксации *E*<sup>'</sup><sub>1</sub>-центров в облученном нейтронами кварцевом стекле

© Л.К. Аминов, И.Н. Куркин, Д.А. Лукоянов, К.П. Чернов

Казанский государственный университет, 420008 Казань, Россия

#### (Поступила в Редакцию 27 января 1997 г.)

Сообщаются результаты измерения времен спин-решеточной релаксации  $E'_1$ -центров в кварцевом стекле, возникающих в результате нейтронного облучения образца, на двух частотах 9.25 и 24.0 GHz в широком интервале температур 1.5–300 К. Экспериментальные данные интерпретируются на основе механизмов взаимодействия спинов с двухуровневыми системами с энергиями возбуждения ~ 6, ~ 26 и ~ 420 cm<sup>-1</sup>. Небольшая модификация существующей теории позволила объяснить ряд особенностей наблюдаемых температурной и частотной зависимостей скорости релаксации. Результаты исследования сопоставляются с имеющимися в литературе данными по спин-решеточной релаксации центров облучения в кристаллическом и стеклообразном кварце.

Интерес к исследованиям кварца обусловлен широким распространением его в природе, многообразием форм существования (различные природные минералы, несколько кристаллических модификаций, стекло, плавленый кварц), важными техническими приложениями. В кварце возможно наличие примесных парамагнитных ионов, точечных дефектных центров, возникающих в результате облучения быстрыми нейтронами и гаммаизлучением, междоузельных примесных атомов водорода. Исследование спектров ЭПР этих центров, времен их спин-решеточной релаксации позволяет получить некоторые сведения о структуре и особенностях спектра возбуждений в кристаллическом и аморфном кварце.

В результате изучения времен спин-решеточной релаксации E'-центров в кварце [1–6] выявились существенные отличия их температурной зависимости от характерной для ионов с эффективным спином S = 1/2 зависимости вида  $T_1^{-1} = AT + BT^9$  [7]. Достаточно хорошо эта зависимость была описана на основе предположения о наличии в системе выделенных по частоте локализованных колебаний, сильно связанных со спинами [3,4]. В широком интервале температур 1.25–250 К результаты измерений скорости релаксации были описаны формулой

$$T_1^{-1} = AT + B\operatorname{cosech}^2 \frac{\Delta_1}{2T} + C\operatorname{cosech}^2 \frac{\Delta_2}{2T}.$$
 (1)

Интересно отметить, что эта формула оказалась одинаково пригодной как для кристаллов, так и для кварцевого стекла.

В дальнейшем модели локальных дефектов, ответственных за спин-решеточную релаксацию, детализировались и уточнялись. В частности, Мэрфи [8] предложил модели туннелирующего осциллятора и иона, движущегося в прямоугольной яме, которые были использованы для объяснения температурной зависимости спинрешеточной релаксации атомарного водорода в плавленом кварце [9]. Первая из этих моделей имеет много общего с концепцией двухуровневых систем, широко используемой сейчас в физике аморфных веществ. Применительно к электронной спин-решеточной релаксации эта концепция впервые была развита Курцем и Стэплтоном [10]. Вклад в скорость релаксации двухуровневой системы (туннелирующего осциллятора) с энергией возбуждения  $\Delta$  имеет вид

$$T_1^{-1} = B \operatorname{cosech} \frac{\Delta}{T} + \dots$$
 (2)

При температурах  $T \ll \Delta$  это выражение, как и соответствующий вклад из (1), может быть представлено в виде экспоненциальной функции  $B \exp(-\Delta/T)$ .

Не противоречит предположению о решающей роли в спин-решеточной релаксации в кварце локализованных колебаний или двухуровневых систем и наблюдавшаяся авторами работы [6] степенная зависимость  $(T_1^{-1} \sim T^3)$  скорости релаксации в области температур 0.2-4.2 К в образцах с высокой дозой облучения (свыше  $10^{17}$  neutron/cm<sup>2</sup>), хотя сами авторы склонны считать более вероятной причиной особенностей релаксации влияние обменных взаимодействий парамагнитных центров. В последнем случае, однако, следовало бы ожидать регулярного возрастания скорости релаксации с ростом концентрации спинов. Фактически же скорость монотонно возрастает с ростом дозы облучения, а при очень больших дозах облучения ( $\sim 10^{20}$  neutron/cm<sup>2</sup>) концентрация спинов уже начинает падать. Степенная зависимость скорости релаксации в некотором интервале температур может быть получена с учетом "размывания", распределения частоты локального колебания, причем показатель степени определяется функцией распределения частоты (ср. [1] и [10]). Снова отметим, что и в экспериментах авторов [6] релаксация в стекле и кристаллах кварца подчинялась одинаковому температурному закону.

Помимо температурной зависимости исследовалась также и зависимость скорости спин-решеточной релаксации E'-центров в кварце от частоты резонансного поля (или величины постоянного магнитного поля) [2,5,11]. Измерения на двух частотах в кристаллах при гелиевых температурах (1.7–4.2 K) [2,5] показали возрастание времени релаксации с ростом частоты, что также противоречит предсказаниям теорий Валлера и Кронига–Ван Флека [7]. Авторы [2,5] предположили, что такая зависимость релаксации связана с кроссрелаксационными эффектами. Эксперименты в кварцевом стекле при комнатной температуре показали [11], что скорость релаксации практически не меняется при низких частотах до ~ 9 GHz и начинает заметно уменьшаться при дальнейшем росте частоты.

Сходство поведения релаксации в кристаллическом и аморфном кварце делает интересным дальнейшее исследование этого явления. Уточнение механизмов релаксации в кварце может помочь в объяснении нестандартных закономерностей спин-решеточной релаксации в других монокристаллах (ср. [12]) и стеклах. В настоящей работе мы сообщаем результаты измерения скорости релаксации дефектных парамагнитных центров в кварцевом стекле на двух частотах в широком интервале температур и проводим их обсуждение.

### 1. Экспериментальные данные

Исследовались образцы кварца, подвергшиеся нейтронному облучению дозой  $10^{20}$  neutron/cm<sup>2</sup>. Наблюдающийся интенсивный спектр ЭПР обусловлен детально исследованным ранее  $E'_1$ -центром (слабо анизотропный спектр с g-факторами  $g_1 = 2.0003$ ,  $g_2 = 2.0006$ ,  $g_3 = 2.0018$  [13]). Характерный спектр ЭПР и рентгеноструктурный анализ свидетельствуют о том, что мы имеем дело со стеклообразным состоянием кварца. Концентрация парамагнитных центров, измеренная методом ЭПР путем сравнения с эталонным образцом, составляла ~  $4 \cdot 10^{18}$  spin/cm<sup>3</sup>.

Измерения спин-решеточной релаксации были выполнены методом импульсного насыщения на частотах  $\sim 9.25\,{
m GHz}$  (X-диапазон) и  $\sim 24.0\,{
m GHz}$  (K-диапазон) в широком интервале температур 1.5-300 К. В Х-диапазоне измерения выполнялись как на самодельном релаксометре, так и на малосерийном автоматизированном релаксометре ИРЭС-1003; в К-диапазоне — на самодельном приборе. Измерения T<sub>1</sub> проводились в магнитном поле, при котором амплитуда сигнала ЭПР была максимальной, что соответствовало компонентам 1,2 g-фактора. Для того чтобы избежать влияния процесса спектральной диффузии внутри линии ЭПР, применялся насыщающий СВЧ-импульс большой длительности (~ 2 ms). Кинетика восстановления намагниченности после насыщающего импульса имела одноэкспоненциальный характер, и время  $T_1$  определялось по формуле

$$A(t) = A_0 \left[ 1 - \exp(-t/T_1) \right].$$

Точность измерения  $T_1$  была не хуже 20%. Результаты измерений  $T_1$  на обсих частотах приведены на рисунке.

## 2. Обсуждение результатов

Как видно из рисунка, при температурах выше гелиевых наблюдается заметное уменьшение скорости релаксации с ростом частоты резонанса. Температурная и частотная зависимости скорости релаксации вполне удовлетворительно описываются формулой

$$T_{1}^{-1} = B_{1} \frac{\gamma_{1}}{\omega_{0}^{2} + \gamma_{1}^{2}} \operatorname{sech}^{2} \frac{\Delta_{1}}{2T} + B_{2} \frac{\gamma_{2}}{\omega_{0}^{2} + \gamma_{2}^{2}} \operatorname{sech}^{2} \frac{\Delta_{2}}{2T} + B_{3} \frac{\gamma_{3}}{\omega_{0}^{2} + \gamma_{3}^{2}} \operatorname{sech}^{2} \frac{\Delta_{3}}{2T},$$
(3)

где  $\omega_0$  — резонансная частота, при следующих значениях параметров:

 $B_{1} = 2.2 \cdot 10^{13} \,\mathrm{s}^{-2}, \ \gamma_{1} = 2.1 \cdot 10^{11} \,\mathrm{s}^{-1}, \ \Delta_{1} = 9 \,\mathrm{K},$   $B_{2} = 8.9 \cdot 10^{14} \,\mathrm{s}^{-2}, \ \gamma_{2} = 1.2 \cdot 10^{11} \,\mathrm{s}^{-1}, \ \Delta_{2} = 38 \,\mathrm{K},$  $B_{3} = 6.0 \cdot 10^{15} \,\mathrm{s}^{-2}, \ \gamma_{3} = 1.5 \cdot 10^{11} \,\mathrm{s}^{-1}, \ \Delta_{3} = 600 \,\mathrm{K}. \ (4)$ 

Слагаемые такого вида в скорости релаксации получаются в модели, в которой релаксация определяется модуляцией магнитных взаимодействий спина в результате случайных переходов близлежащей двухуровневой системы между своими двумя состояниями. При этом  $\gamma$  является частотой корреляции случайного процесса; в двухуровневой системе она примерно равна обратному времени жизни возбуждения. В приближении  $\omega_0 \gg \gamma$  формула (3) может быть получена прямым расчетом по теории возмущений с учетом гамильтонианов взанмодействия спина с двухуровневой системой и двухуровневой системы с окружением. Именно это было сделано авторами работы [10], которые рассмотрели взаимодействие двухуровневых систем с акустическими



Спин-решеточная релаксация  $E'_1$ -центров в кварцевом стекле в зависимости от температуры и частоты. Сплошные линии проведены по формуле (3) с параметрами (4). Для наглядности приведены прямые линии, соответствующие скоростям релаксации, пропорциональным  $T^3$  и  $T^1$ .

фононами. В этом случае  $\gamma \sim \coth(\Delta/2T)$ , и выражение (3) сводится к (2). Таким образом, формулу (3) можно считать полуфеноменологическим обобщением формулы (2), позволяющим учесть иные (чем фононные) механизмы случайных переходов и произвольные соотношения между  $\omega_0$  и  $\gamma$ . При высокой концентрации двухуровневых систем с одинаковыми энергиями возбуждения  $\Delta$  должны проявляться процессы переноса энергии между ними, и естественно представить частоту корреляции в виде

$$\gamma = a + b \coth(\Delta/2T), \tag{5}$$

где первое слагаемое практически не зависит от температуры, но существенно определяется дозой облучения образца. Использование формул (3), (5) позволяет описать такие любопытные особенности экспериментальных результатов, как резкое различие в характере частотной зависимости скорости релаксации при низких и высоких температурах и выход температурной зависимости скорости на плато при температурах 40–100 К. Для сравнения заметим, что формулы (1) и (2) приводят соответственно к квадратичной и линейной зависимостям в этой области температур.

Каждое из слагаемых в формуле (3) связано с определенным типом двухуровневых систем и вносит преобладающий вклад в скорость релаксации в некотором интервале температур. При этих температурах частотная зависимость практически отсутствует в области частот  $\omega_0 < \gamma$ , а с увеличением частоты ( $\omega_0 > \gamma$ ) скорость релаксации начинает заметно падать. Как видно, частотная зависимость скорости релаксации позволяет грубо оценить время жизни возбуждения двухуровневой системы, а значит, и величину связи двухуровневой системы с окружающей средой.

В эту схему хорошо вписываются результаты работы [11], упомянутые выше. Тот факт, что при гелиевых температурах мы не наблюдали изменения скорости релаксации при переходе от частоты 9 к 24 GHz, а в работе [5] отмечено существенное изменение скорости релаксации при переходе к частоте 37 GHz, можно объяснить тем, что в нашем случае  $\gamma_1$  несколько больше, чем в [5], ввиду более высокой дозы облучения и большей концентрации дефектов.

В области гелиевых температур наши данные по температурной зависимости скорости релаксации согласуются с результатами работы [6] для образцов, подвергавшихся высоким дозам облучения. При более высоких температурах имеется качественное соответствие с результатами работ [3,4]. Однако измеренные нами абсолютные величины скоростей релаксации намного больше, что, очевидно, связано с намного меньшей концентрацией дефектов в образцах, исследованных в [3,4].

Таким образом, в рамках модели взаимодействия спинов с двухуровневыми системами с определенными энергиями возбуждения удается качественно описать целый ряд различных особенностей спин-решеточной релаксации дефектных парамагнитных центров в кристаллическом и аморфном кварце. В заключение выражаем благодарность С.С. Царевскому за проведение рентгеноструктурного анализа образца, В.А. Иваньшину и Л.Л. Седову за помощь в проведении экспериментов.

## Список литературы

- J.G. Castle, D.W. Feldman, P.G. Klemens, R.A. Weeks. Phys. Rev. 130, 2, 577 (1963).
- [2] Я.Л. Шамфаров, Т.А. Смирнова. ФТТ 5, 4, 1046 (1963).
- [3] J.G. Castle, D.W. Feldman. J. Appl. Phys. 36, 1, 124 (1965).
- [4] J.G. Castle, D.W. Feldman. Phys. Rev. 137, 2A, A671 (1965).
- [5] Я.Л. Шамфаров. ФТТ **8**, *9*, 2605 (1966).
- [6] V.D. Korolev, S.A. Peskovatskii. V.M. Shulga. Phys. Stat. Sol.
  (b) 151, *1*, K45 (1979).
- [7] С.А. Альтшулер, Козырев Б.М. Электронный парамагнитный резонанс. М. (1972). 672 с.
- [8] J. Murphy. Phys. Rev. 145, 1, 241 (1966).
- [9] D.W. Feldman, J.G. Castle, G.R. Wagner. Phys. Rev. 145, 1, 237 (1966).
- [10] S.R. Kurtz, H.G. Stapleton. Phys. Rev. B22, 5, 2195 (1980).
- [11] B.T. Ghim, S.S. Eaton, G.R. Eaton, R.W. Quine, G.A. Rinard, S.J. Pfenninger. Magn. Res. A115, 230 (1995).
- [12] Л.К. Аминов, И.Н. Куркин. ФТТ 37, 9, 2684 (1995).
- [13] М.В. Власова, Н.Г. Каказей, А.М. Калиниченко, А.С. Литовченко. Радиоспектроскопические свойства неорганических материалов. Наук. думка, Киев (1987). 720 с.